

2SD636, 2SD637

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

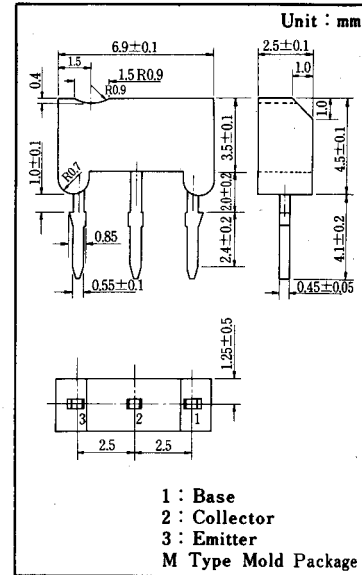
低電力一般増幅用

■ 特長

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。
- M型パッケージで自動挿入、手挿入が容易、P板に自立固定できる。

■ 絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD636	30	V
	2SD637	60	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD636	25	V
	2SD637	50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	200	mA
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=20\text{V}, I_B=0$			1	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	30			V
			60			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=2\text{mA}, I_B=0$	25			V
			50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=2\text{mA}$	160		460	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$		0.3	0.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=-2\text{mA}, f=200\text{MHz}$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		3.5		pF

* h_{FE} ランク分類

ランク	Q	R	S
h_{FE}	160~260	210~340	290~460